

	<p>SQJ886EP-T1_GE3</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SQJ886EP-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SQJ886EP-T1_GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Liefern von: Hong Kong</p>	
<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ886EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 15.3A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2922pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SQJ886EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ886EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ886EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ886EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ872EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 150V</p>	 <p>SQJ860EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>	 <p>SQJ912AEP-T1 VISHAY SQJ912AEP-T1 VISHAY</p>	 <p>SQJ912AEP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SQJ886EP-T1-GE3 VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p>SQJ886EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ912AEP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 40V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SQJ860EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ886EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ886EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ886EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ886EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ886EP-T1_GE3
SQJ886EP-T1_GE3 Electronic	SQJ886EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ886EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ886EP-T1_GE3-Bild	SQJ886EP-T1_GE3-Teil
SQJ886EP-T1_GE3 Preis	SQJ886EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ886EP-T1_GE3 Bild	SQJ886EP-T1_GE3 Aktie	SQJ886EP-T1_GE3 Inventar
SQJ886EP-T1_GE3 Neu	SQJ886EP-T1_GE3 Original	SQJ886EP-T1_GE3 garantiert	SQJ886EP-T1_GE3 RFQ	SQJ886EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited